SZENTIDAY KLÁRA Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola

Lavina-fotodiódák alkalmazása impulzusüzemű zárófeszültséggel

ETO 621.383.52.018.756

A lavina-fotodióda olyan pn átmenetet tartalmazó fotodetektor, amelyben a fény által keltett töltéshordozók ütközési ionizációval sokszorozódnak. Ennek eléréséhez meglehetősen nagy, tipikusan 100 V feletti zárófeszültséget kell az eszközre adni. A lavinasokszorozódás időben rendkívül gyorsan lejátszódó folyamat, ezért ha a diódát elegendően kicsiny átmenetterületűre készítik az eszköz a GHz nagyságrendjébe eső fénymodulációs frekvenciákig működtethető. A multiplikálódás miatti 100...500-szoros belső erősítés következtében tehát a lavina-fotodióda erősítés-sávszélesség szorzata valamennyi fotodetektor közül a legnagyobb.

A lavina-fotodiódák egyre szélesebb körű elterjedése indokolttá teszi azok működésének és működtetési módjainak további vizsgálatát. Az eszközt – miként a záróréteges pn-fotodiódákat – alkalmazása során állandó zárófeszültséggel látják el, és a detektálandó fénynyalábot szaggatják, ill. modulálják. Így váltakozóáramú jel erősítése és regisztrálása lehetséges. Kérdés, hogyan viselkedik az eszköz, ha a megvilágítás erőssége időben állandó, és a zárófeszültséget változtatják. Ez a működtetési mód csakis lavinasokszorozódássa¹ rendelkező eszköznél lehetséges, mert a pn-diódáknál a zárófeszültség változtatása a kimenő jel lényegtelen változását vonja maga után.

A lavina-fotodióda impulzusüzemű zárófeszültséggel való működtetése jelentős lehet az olyan alkalmazásoknál, ahol időben állandó (illetve lassan változó) fényjelet kívánunk váltakozó áramjelként detektálni. Ebben az esetben a zárófeszültség szaggatása helyettesítené a mechanikus (pl. forgó tárcsa vagy tükör) fényszaggatót. Lehetséges azonban olyan alkalmazás is, amikor mind a fényjelet, mind a zárófeszültséget modulálják: ebben az esetben a lavina-fotodióda szorzó- (keverő) áramkör funkcióját látná el.

1. Elméleti vizsgálatok

A lavina-fotodiódák váltakozó fényjelű multiplikációs folyamatait számos szerző vizsgálta, közöttük Emmons és Lucovsky [1], Chang [2], valamint Misawa [3]. A kiindulás alapját a félvezetőkre érvényes transzportegyenletek és a Poisson-egyenlet [4] képezte. Az egyenletek általános alakja csapdaszinteket nem tartalmazó félvezetők esetében:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{(p-p_e)}{\tau} + g - \frac{1}{q} \operatorname{div} J_p, \qquad (1)$$

Beérkezett: 1978. V. 10.

 $\frac{\partial \mathbf{n}}{\partial t} = -\frac{(\mathbf{n} - \mathbf{n}_e)}{\tau} + g - \frac{1}{q} \operatorname{div} J_n, \qquad (2)$

$$J_p = q\mu_p p E - qD_p \text{ grad } p, \qquad (3)$$

$$J_n = q\mu_n n E + qD_n \text{ grad } n, \tag{4}$$

$$J = J_p + J_n + \varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}, \qquad (5)$$

div
$$E = \frac{q}{\varepsilon \varepsilon_0} [(\mathbf{p} - p_e) - (\mathbf{n} - \mathbf{n}_e) + N_D^+ - N_A^-],$$
 (6)

ahol:

p és n a lyukak, ill. az elektronok sűrűsége;
p, és n, az egyensúlyi töltéshordozó sűrűségek;

- τ a töltéshordozók élettartama;
- g a generáció mértéke;
- μ a töltéshordozók mozgékonysága;
- D a diffúziós állandó;
- J az áramsűrűség;
- E az elektromos térerősség;
- N_D^+ és $N_{\overline{A}}$ az. ionizált donor, ill. akceptoratomok sűrűsége.

Záróirányú előfeszültségnél PIN-struktúra esetén a kiürített rétegben a térerősség olyan nagy, hogy a töltéshordozók futási ideje sokkal kisebb a rekombináció időállandójánál. Így az (1) és (2) egyenletben szereplő rekombinációs tagok elhanyagolhatók. Ugyancsak a nagy térerősség következménye, hogy az áramsűrűséget kifejező (3) és (4) egyenletekben a vezetési áramösszetevő mellett a diffúziós komponens elhanyagolható. Egyenfeszültséggel lezárva az átmenetet, az (5) egyenletben szereplő utolsó tag is elhagyható, amennyiben a terhelő ellenálláson eső feszültség sokkal kisebb az átmeneten eső feszültséghez képest (rövidzárási áram mérése).

A generáció mértékét, az időegység alatt keltett töltéshordozó-sűrűséget a g tényező írja le:

$$g(x, t) = g'(x, t) + \alpha \mu_n \mathbf{n} E + \beta \mu_p \mathbf{p} E.$$
(7)

A g'(x, t) tag a fényelektromos generáció mértékére jellemző, míg a másik két tag a lavina multiplikáció révén sokszorozódott töltéshordozó-sűrűséget adja meg; α és β az elektronok, ill. a lyukak ionizációs mértékét jelentik, tehát az egységnyi úthossz befutására eső ionizációs valószínűséget. Ha a gerjesztés mértéke az időtől függetlenül állandó (állandó fényerősséggel való megvilágítás esete):

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial n}{\partial t} = 0,$$

és a megoldás:

$$J_{dc} = J_{n0} + J_{p0} =$$

$$= \frac{\int_{0}^{w} qg_{0} \exp\left\{\int_{0}^{x} (\alpha - \beta) \, \mathrm{d}x'\right\} \mathrm{d}x}{1 - \int_{0}^{w} \beta \exp\left\{\int_{0}^{x} (\alpha - \beta) \, \mathrm{d}x'\right\} \mathrm{d}x}, \qquad (8)$$

ahol:

w a kiürített réteg szélességét jelenti és g_0 a g'(x, t) időfüggetlen tagja.

A számításoknál feltételezték, hogy a mozgó töltéshordozók okozta térerősség-változás elhanyagolható a pn átmenét erőteréhez képest.

A J_{dc} egyenáramú áramsűrűséget kifejező (8) megoldás részletesebb kifejtéséhez a dióda felépítésének ismerete is szükséges. Általánosságban a következő megállapításokat tehetjük:

1. Ha $\alpha = \beta$, tehát az elektronok és lyukak ionizációs mértéke egyenlő, az exponensben szereplő integrálok értéke α -tól és β -tól függetlenül állandó. Feltételezve, hogy α és β helyfüggetlen, a fotoáram az ionizációs mértéktől csak igen kevéssé függ.

2. J_{dc} értéke nő, ha $\alpha \gg \beta$, a multiplikálódó fotoáram számára tehát kedvező, ha az ionizációt döntő mértékben a nagyobb ionizációs mértékkel rendelkező töltéshordozók hozzák létre. Sziltcium esetében ezek a töltéshordozók az elektronok.

A multiplikációs tényező meghatározásához a fotoáram multiplikáció nélküli értékét is ki kell számítani. Ekkor $\alpha = \beta = 0$, tehát a (7) egyenletben szereplő generációs mérték a g' értékkel lesz azonos. Állandó zárófeszültségnél és állandó megvilágításnál

$$J_{de0} = \int_{0}^{w} qg_0 \,\mathrm{d}x. \tag{9}$$

Az M multiplikációs tényező értékét a (8) és (9) egyenlet hányadosa adja:

$$M = \frac{J_{dc}}{J_{de0}}.$$
 (10)

Impulzusüzemű zárófeszültség

Ha állandó megvilágítási szint mellett a zárófeszültséget impulzusüzemben adjuk a lavina diódára, négy időszakaszban kell a folyamatot vizsgálni (l. 1. ábra).

1. Az impulzusok közötti szünetek t_0 időszakasza. Ekkor a diódára kicsiny, esetleg néhány voltos zárófeszültség jut, amely biztosítja a zárófeszültséges működést, azonban multiplikációs folyamatot nem okoz. A kiürített réteg ekkor keskeny és feltételezhető, hogy a kiürített rétegen kívüli tartományban abszorbeálódott fotonok is hozzájárulnak a fotoáramhoz.



1. ábra. A lavina-folodiódára jutó zárófeszültség-impulzus ielalakia 2. A zárófeszültség állandósult, $t_{\rm áli}$ időszakasza: Ekkor a diódára jutó zárófeszültség maximális, és a fotoáram értéke a (8) egyenlettel, ill. a multiplikáció a (10) egyenlettel fejezhető ki. (Ennél a megállapításnál feltételezzük, hogy a diódára jutó zárófeszültség-impulzus időtartama nagyobb a diódában lejátszódó tranziensek idejénél.)

3. A feszültségimpulzusok emelkedési és esési (t_i) időszakasza. Tételezzük fel, hogy a feszültségimpulzus időbeli változása lineáris, tehát a fel- és lefutási időben

 $U=ai, \tag{11}$

ahol *a* a meredekség. Ebben az időszakaszban két tényező befolyásolja az áram alakulását:

a megvilágítás által gerjesztett töltéshordozók sokszorozódása;

a kapacitív áramösszetevő.

A sokszorozódás ebben az esetben lényegesen eltér az egyenfeszültségű esettől, mivel az állandó megvilágítás következtében állandó fotoáram folyik, és ez a fotoáram a kiürített réteg szélességének időbeli változását követve sokszorozódik. (11) értelmében tehát

$$M = M(t) \tag{12}$$

adódik. M(t) pontos meghatározása igen bonyolult feladat, mivel csaknem valamennyi jellemző időfüggő. A (7) egyenlet által megadott gerjesztési tag

$$g(x, t) = g'(x) + \alpha(E(t)) \cdot \mu_n nE(t) + \beta(E(t))\mu_p pE(t) \quad (13)$$

alakú lesz, és az (1)...(6) egyenletekben szereplő áramsűrűség- és térerősség-tagok is időfüggőek lesznek. Végül időfüggő lesz a w kiürített rétegszélesség is w zárófeszültség-függése következtében, és így időfüggővé válik a (8) egyenletben szereplő integrál határa is.

A második lényeges különbség az egyenfeszültségű alkalmazáshoz képest abból adódik, hogy az impulzusfelfutás időtartama alatt jelentős kapacitív áram lép fel, mivel az (5) egyenletben szereplő térerősségváltozásra nézve

$$\varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} \neq 0$$

adódik. A kapacitív áramsűrűség

$$J_{ac}^{e} = \varepsilon \varepsilon_{0} \frac{\partial E}{\partial t} = \varepsilon e_{0} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{U(t)}{w} \right)$$
(14)

alakban írható fel, ahol w a kiürített réteg szélessége. Tekintve, hogy w is függ az átmenetre jutó záró-, feszültségtől, így (14)-ben mind U, mind w időfüggő. Tételezzük fel, hogy a lavina dióda p+n átmenete lépcsős struktúrájú, és a két oldal adalékoltsága olyan, hogy a p+ oldalra jutó kiürített réteg szélessége elhanyagolható az n oldaléhoz képest:

$$w = w_n + w_n \cong w_n. \tag{15}$$

Ugrásátmenetnél, mint ismeretes:

$$w_n = \sqrt{\frac{2ee_0 U_z}{qN_D}},\tag{16}$$

ahol $U_z = U(t) + U_0$. U_0 az átmenet érintkezési potenciálja (Si esetében mintegy 0,6...0,7 V), amely – értelemszerűen – időfüggetlennek tekinthető. Behelyettesítve (14)-be és (16)-ba a (11) összefüggést t=0 esetén

$$J_{ac}^{c}(t=0) = \frac{U}{t_{e}} \sqrt{\frac{q \varepsilon \varepsilon_{0} N_{D}}{2U_{0}}}$$
(17)

adódik és $t = t_{\rho}$ esetében a

$$J_{ac}^{c}(t=t_{e}) = \frac{U}{t_{e}} \sqrt{\frac{q\varepsilon\varepsilon_{0}N_{D}}{2U_{0}}} \cdot \frac{2U_{0}+U}{2(U_{0}+U)^{3/2}}$$
(18)

eredményt kapjuk. Ha $U \gg U_0$:

$$J_{ac}^{e}(t=t_{e}) \cong \frac{U}{t_{e}} \sqrt{\frac{q \varepsilon \varepsilon_{0} N_{D}}{2U_{0}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{U}}.$$
 (19)

Képezve (17) és (19) hányadosát:

$$\frac{J_{ac}^{c}(t=0)}{J_{c}^{ac}(t=t_{e})} = 2\sqrt{U}$$
⁽²⁰⁾

adódik.

A fenti áramcsökkenés annak eredménye, hogy a kiürített réteg szélessége is feszültség- (111. idő-) függő. Ha az átmenetkapacitás időben nem változnék, a bekapcsolás pillanatától kezdve a jól ismert

$$J_{ac}^{c} = C'a \tag{21}$$

áramsűrűséget kapnánk, ahol C' a felületegységre jutó kapacitást jelenti. Hangsúlyozzuk, hogy a számításokban szereplő J_{ac}^{c} -értékek kizárólag a kapacitiv áramot jelentik, tehát az ellenállásokkal kiegészített teljes áramkörben folyó tényleges áram az ellenállások korlátozó hatását ís magában foglalja.

Áttekintve a fenti eredményeket, nyilvánvaló, hogy a lavina-fotodióda impulzusüzemű működtetésének legfőbb nehézsége a zárófeszültség-impulzusok fel- és lefutásakor jelentkező nagy értékű kapacitív áram, amely kedvezőtlenül befolyásolja a működést.

2. Kísérletek

Alapkapcsolás vizsgálata

Nagyfeszültségű impulzusok előállítására sokféle kapcsolás készíthető. Az impulzusamplitúdót a lavinadiódára maximálisan megengedett zárófeszültség korlátozza, ez az érték a legtöbb típusnál 50...250 V közé esik. Olyan meghajtó tranzisztor szükséges tehát, amely ebben a feszültségtartományban alkalmazható. Méréseinkhez BF 259 típusú eszközt alkalmaztunk, amelynek U_{CEO} értéke 300 V. Inverter kapcsolásban működtetve a tranzisztort, a fokozat vezérléséhez bármilyen, néhány volt amplitúdójú



 ábra. Lavina-fotodióda impulzusüzemű működtetésére alkalmas egyszerű kapcsolás

pozitív impulzussorozat megfelel. Alkalmazható kész impulzusgenerátor, vagy pl. TTL-kapukból kialakítható inverter-oszcillátor [5]. Nagy pontosságú ismétlődési frekvencia igénye esetén kristályvezérelt oszcillátorkapcsolást célszerű készíteni.

A mérőkapcsolást a 2. ábra szemlélteti. Az R_1 ellenállást úgy kell megválasztani az R_2 -höz képest, hogy a T_1 tranzisztor telítése esetén is jusson a lavinadiódára legalább 1 V zárófeszültség. Az R_3 ellenállás sarkairól levett feszültségjel állandósult értéke a megvilágítással arányos. A kapacitív áramcsúcs csökkentése céljából a C kondenzátorral hidaltuk át a munkaellenállást, amely integráló hatást fejt ki.

Linearitásvizsgálat

A gyakorlati alkalmazásoknál feltétlenül előnyben részesül az a fotodetektor, amely lineáris működésű, tehát a megvilágítás 1:2:3... növelésével a válaszjelnek is 1:2:3... arányú növekedése figyelhető meg. Mint ismeretes, [6] a rövidzár-üzemben működő fényelemek és a záróréteges fotodiódák nagy pontossággal eleget tesznek ennek a követelménynek, ugyanakkor a fényelem üresjárási feszültsége logaritmikusan függ a megvilágítástól, és a fotoellenállások válaszjelváltozása szintén a logaritmikus menethez áll közel.

A lavina-fotodióda, amely lényegében multiplikációval rendelkező záróréteges fotodiódának tekinthető, ugyancsak lineáris viselkedésű abban a megvilágítástartományban, amelyben az M multiplikációs tényező szintfüggetlen. A multiplikáció meghatározásánál, tehát az (1)...(6) egyenletek megoldásánál feltételként szerepelt a kisszintű injekció, vagyis hogy a megvilágítással létrehozott többlet töltéshordozó-sűrűség sokkal kisebb az egyensúlyi töltéshordozó-sűrűségnél. Mivel a (7) egyenletben szereplő g generációs mérték az α és β ionizációs tényezőktől és a mozgékonyságoktól is függ, ezek szintfüggése is szerephet juthat. A részletesebb elméleti vizsgálatok mellőzésével is belátható tehát, hogy a lavina-fotodióda – éppen a multiplikálódás miatt – hamarabb átlépi a kisszintű injekciót, mint egy hasonló felépítésű PIN fotodióda. Ennek tudható be, hogy a lavina-fotodiódák általában szűkebb megvilágítástartományban tekintendők lineárisnak, mint az a gyártó cégek adatlapjain szereplő értékekből is kitűnik.

A lavina-fotodióda impulzusüzemű működésénél ugyancsak meg kell vizsgálnunk a linearitás kérdését. Mint rámutattunk, az állandósult tartományban elvileg nincs eltérés az állandó zárófeszültségű műkedéshez képest, azonban az átmeneti tartományban a kapacitív áramlökések következtében a dióda viselkedése messze nem lineáris. Ezt a hátrányt valamilyen áramköri megoldással kell kiküszöbölni, a válaszjelből ki kell vágni vagy ki kell szűrni a kellemetlen kapacitív komponenst.

Egy lehetséges áramköri megoldást mutat be a 3. ábra kapcsolása. A lavinadióda fotoáramát 741 műveleti erősítőre vezetjük, amelynek R_v visszacsatoló ellenállását kondenzátorral hidaltuk át. C_v értékét olyanra kell választani, hogy az alkalmazott maximális megvilágításnál éppen kiintegrálja a kapacitív áramcsúcsot. Az első fokozat jelét három-



 ábra. Impulzusüzemben működtetett lavina-fotodióda linearitásyizsgálatára szolgáló kapcsolás

fokozatú aktív aluláteresztő szűrőre vezettük, amely maximális laposságra méretezett; határfrekvenciája $f_0=11$ Hz és erősítése: A=2 fokozatonként. A szűrőkör méretezési egyenletei megtalálhatók a [7] irodalomban. Az általunk vizsgált kapcsolás adatai:

A szűrő kimeneti jelét indikátorműszerre (voltmérő, oszcilloszkóp) vezetve vizsgálhatjuk.

Linearitásvizsgálatnál problémát okoz a fény ismert arányú gyöngítése. Erre a célra szürke szűrősorozatot alkalmaztunk, amelynek gyengítési tényező-hullámhossz függését előzőleg meghatároztuk. Az eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.

A lavina-fotodiódán végzett méréseket 140 V és 150 V zárófeszültségű impulzusokkal végeztük. A szállámpa a lavinadiódától 8,5 cm-re helyezkedett el. A lámpát egyenfeszültségről tápláltuk: 6 V, 660 mA-es és 5 V, 595 mA-es beállításban. A lámpa színhőmérséklete az első esetben 2482 K és a második esetben 2351 K volt. A mért gyengítési tényezőket a 2. táblázat tartalmazza.

A vizsgált eszközök hullámhosszfüggő viselkedését a 4. ábra szemlélteti. Itt feltüntettük a TIXL 55 lavina-fotodióda relatív kvantumhatásfokát, az alkalmazott izzólámpa spektrális emisszióját 2400 K színhőmérsékletnél $\lambda = 1200$ nm-re normáiva, továbbá ábrázoltuk a szűrők gyöngítési együtthatójának hullámhosszfüggését.

Az I. és II. táblázat összehasonlítása alapján az

NG 3 szűrőnél a	875950 nm;
NG 4 szűrőnél a	875925 nm;
NG 5 szűrőnél a	850875 nm

1. táblázat

Szűrősorozat gyengítési tényezőinek monokromátorral mért értékei

λ nm	NG 3	NG 4	NG 5	
800	0,0393	0,213	0,345	
825	0,0405	_0,212	0,332	
850	0,0398	0,208	0,302	
875	0,0388	0,209	0,288	
900	0,0378	0,204	0,273	
925	0,0365	0,198	0,259	
950	0,0357	0,188	0,249	

2. táblázat Szűrősorozat gyengítési tényezőinek impulzusüzemű lavina-fotodiódával mért értékei

Szűrő	Lámpa- fesz. (V)	140 V	150 V
NG 3	5	$0,0355 \pm 0,0017$	$0,0385 \pm 0,0015$
	6	$\textbf{0,0363} \pm \textbf{0,0015}$	$\textbf{0,0384} \pm \textbf{0,0015}$
NG 4	5	$\textbf{0,}193 \pm \textbf{0,}004$	$\textbf{0,}197 \pm \textbf{0,}004$
	6	$\textbf{0,200} \pm \textbf{0,004}$	$\textbf{0,200} \pm \textbf{0,004}$
NG 5	5	$\textbf{0,295} \pm \textbf{0,003}$	$0,294\pm0,003$
	6	$\textbf{0,297} \pm \textbf{0,003}$	$\textbf{0,301} \pm \textbf{0,003}$
	1 · · ·		





hullámhossztartományban mért értékek feleltethetők meg egymásnak. A 4. ábrán felvett spektrális eloszlások alátámasztják ezt a feltételezést, és az NG 5 esetében tapasztalható, rövidebb hullámhosszak felé való eltolódást a szűrő karakterisztikája magyarázza.

Vizsgálataink alapján az impulzusüzemben működtetett lavina-fotodióda lineáris viselkedésére következtethetünk.

A szerző köszönetét fejezi ki Káldi Tibornak, az Országos Mérésügyi Hivatal munkatársának az optikai mérésekben nyújtott segítségéért.

IRODALOM

- R. B. Emmons—G. Lucovsky: The Frequency Response of Avalanching Photodiodes; IEEE Trans. on Electron Devices, ED—13, 297, 1966.
 J. J. Chang: Frequency Response of PIN Avalanching
- [2] J. J. Chang: Frequency Response of PIN Avalanching Photodiodes; IEEE Trans. on Electron Devices, ED-14, 139, 1967.
- [3] T. Misawa: Negative resistance in p-n junctions under avalanche breakdown condition; IEEE Trans. on Electron Devices, ED-13, 137, 1966.
- [4] A. B. Phillips: Transistor Engineering; McGraw-Hill Book Co., Inc.; New York, 1962.
- [5] Simonfai L.—Pótzy P.—Mayer G.: Digitális integrált áramkörök alkalmazástechnikája; BME Továbbképző Intézete; 4757., 1972.
- [6] Szentiday Klára: Félyezető fotodetektorok; Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1977.
- [7] U. Tietze-Ch. Schenk: Analóg és digitális áramkörök; Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1974. 2. kiadás.